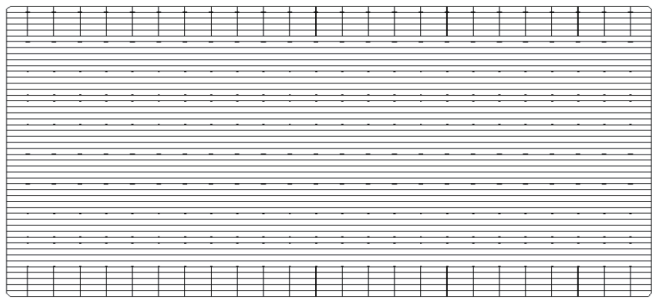


高效异质结电池

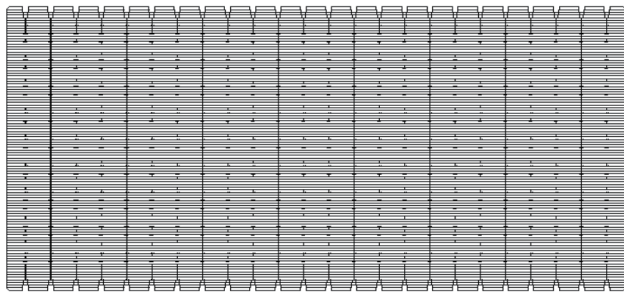
G12 | 210 半片双面

RHA-H02-02-00

电池片图形



正面



背面

产品优势



效率

平均效率26.2%以上



发电量

发电量增益5%以上



双面率

双面率达90%以上



工艺

4~6步工艺



污染

无氨氮废水产生



量产

可实现110um厚度硅片的量产应用



工艺温度

最高制程工艺温度不超过250℃



良率

平均生产良率达99%



无衰减

无PID, LID效应



温度系数

低温度系数

主要电性能规格参数

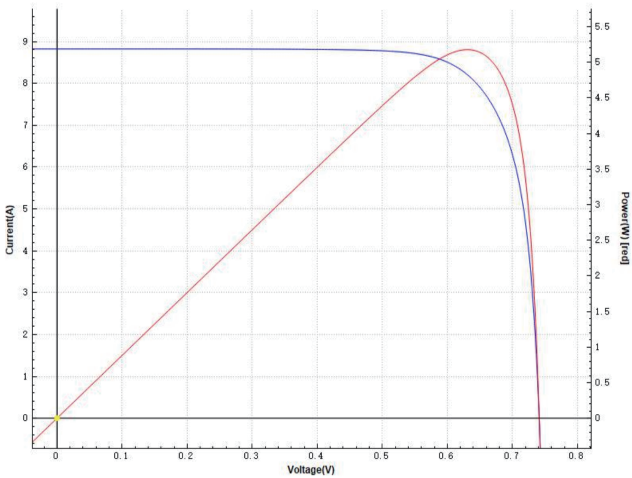
效率	功率	开路电压	短路电流	填充因子	最大功率点电压	最大功率点电流
Eff (%)	Pmpp(W)	Uoc(V)	Isc (A)	FF (%)	Umpp(V)	Impp(A)
26.30	5.80	0.753	8.835	87.18	0.685	8.467
26.20	5.78	0.753	8.824	86.94	0.684	8.445
26.10	5.75	0.752	8.817	86.79	0.683	8.425
26.00	5.73	0.752	8.810	86.53	0.682	8.405
25.90	5.71	0.751	8.796	86.45	0.681	8.385
25.80	5.69	0.750	8.780	86.38	0.680	8.365
25.70	5.67	0.750	8.769	86.16	0.679	8.345
25.60	5.64	0.750	8.759	85.92	0.679	8.313
25.50	5.62	0.749	8.745	85.84	0.678	8.292
25.40	5.60	0.749	8.734	85.61	0.678	8.260
25.30	5.58	0.748	8.725	85.47	0.677	8.240
25.20	5.56	0.748	8.715	85.23	0.676	8.219
25.10	5.53	0.748	8.709	84.95	0.675	8.199
25.00	5.51	0.747	8.699	84.82	0.674	8.178

标准测试条件：1000W/m²，AM1.5，25℃；以上技术参数受限于技术变更及测试。

温度系数

Voc (%/℃)	~-0.27%/℃
Isc (%/℃)	~0.055%/℃
Pm (%/℃)	~-0.258%/℃

I-V特性曲线



产品规格

尺寸	210 mm*105 mm±0.25 mm
基体材料	n型单晶硅
厚度	110±20 μm
正面(-)	蓝色透明导电膜(TCO)
背面(+)	蓝色透明导电膜(TCO)

包装信息

数量	24包/箱，140片/包，3360片/箱
尺寸	60cm*30cm*30.5cm